

Invenția se referă la tehnica cu semiconductori și poate fi utilizată pentru detectarea câmpurilor magnetice și electromagnetice în sistemele electronice și optoelectronice moderne.

Senzorul fotoelectromagnetic include un strat activ semiconductor de tip  $no(p0)$  depus pe un substrat semiconductor semiizolator, pe stratul activ fiind depuse contacte ohmice de alimentare și contacte ohmice pentru înregistrarea tensiunii Hall. Pe stratul activ  $no(p0)$  este depus local un strat semiconductor  $p+(n+)$ , pe care este format un contact ohmic, cu posibilitatea iluminării stratului  $p+(n+)$ .

Revendicări: 1

Figuri.: 1